

94-0147

**Rezumat:**

Invenția se referă la tehnologia semiconductorilor și poate fi utilizată pentru obținerea straturilor subțiri InP pure cu parametri electrofizici reproductibili înalți.

Procedeul propus constă în tratarea termică prealabilă a sursei de indiu și creșterea epitaxială a straturilor în sistemul In-PCl<sub>3</sub>-H<sub>2</sub>, tratarea termică prealabilă a sursei de indiu fiind efectuată în vid.

Rezultatul tehnic al invenției constă în purificarea sursei de indiu de impurități necontrolate și reducerea duratei de stabilire în regimul de creștere a straturilor InP.

Revendicări: 1